单 N 沟道 MOSFET

ELM55004SA-S

www.elm-tech.com

■概要

ELM55004SA-S 是 N 沟道低输入电容,低工作电压,低导通电阻的大电流 MOSFET。

■特点

- Vds=40V
- Id=15A
- Rds(on) = 5.5m Ω (Vgs=10V)
- Rds(on) = 6.5m Ω (Vgs=4.5V)

■绝对最大额定值

如没有特别注明时, Ta=25℃

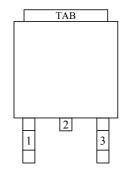
项目		记号	规格范围	单位	
漏极 – 源极电压		Vds	40	V	
栅极 – 源极电压		Vgs	± 20	V	
漏极电流(Tj=150℃)	Ta=25 ℃	T.1	15	A	
	Ta=70°C	Id	12		
漏极电流(脉冲)		Idm	40	A	
单脉冲崩溃电流	L=0.1mH	Ias	25	A	
持续崩溃能量	L=0.1mH	Eas	35	mJ	
容许功耗	Tc=25 ℃	Pd	40	W	
	Tc=70°C	Pa	15		
动作结合部温度		Tj	150	$^{\circ}\!\mathrm{C}$	
保存温度范围		Tstg	− 55 ~ 150	$_{\mathcal{C}}$	

■热特性

项目	记号	典型值	最大值	单位
最大结合部 – 环境热阻	Rθja		62.5	°C/W

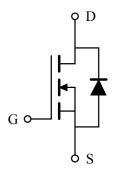
■引脚配置图

TO-252-3(俯视图)



引脚编号	引脚名称
1	GATE
2	DRAIN
3	SOURCE

■电路图





单 N 沟道 MOSFET ELM55004SA-S

http://www.elm-tech.com

■电特性

如没有特别注明时, Ta=25℃

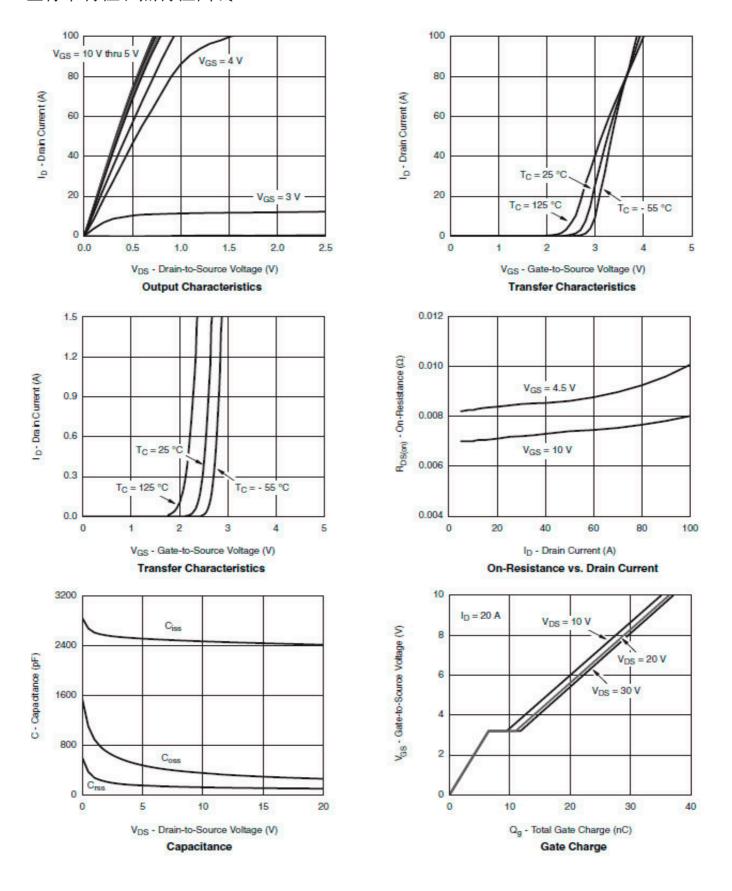
项目	记号	条件			最大值			
静态特性								
漏极 – 源极击穿电压	BVdss	Id=250 μA, Vgs=0V	40			V		
栅极接地时漏极电流	Idss	Vds=32V,Vgs=0V			1			
		Vds=32V,Vgs=0V, Ta=85 °C			10	μΑ		
栅极漏电电流	Igss	$Vds=0V, Vgs=\pm 20V$			± 100	nA		
栅极阈值电压	Vgs(th)	Vds=Vgs, Id=250 μA	1.0		2.0	V		
导通时漏极电流	Id(on)	Vgs=10V, Vds≥5V	50			A		
漏极 – 源极导通电阻	Rds(on)	Vgs=10V, Id=20A		3.5	5.5	$m\Omega$		
		Vgs=4.5V, Id=15A		4.5	6.5			
正向跨导	Gfs	Vds=15V, Id=15A		75		S		
二极管正向压降	Vsd	Is=10A, Vgs=0V		0.85	1.30	V		
寄生二极管最大连续电流	Is				2.6	A		
动态特性								
输入电容	Ciss			2500		pF		
输出电容	Coss	Vgs=0V, Vds=20V, f=1MHz		280		pF		
反馈电容	Crss			120		pF		
开关特性								
总栅极电荷	Qg	Vgs=4.5V, Vds=20V $Id = 20A$		18	30	пC		
栅极 - 源极电荷	Qgs			7		nC		
栅极 - 漏极电荷	Qgd	10 = 20A		5		nC		
导通延迟时间	td(on)	$Vgs=10V, Vds=20V$ $RL=1\Omega, Id \equiv 20A$ $Rgen=1\Omega$		10	20	ns		
导通上升时间	tr			6	15	ns		
关闭延迟时间	td(off)			40	65	ns		
关闭下降时间	tf			6	15	ns		



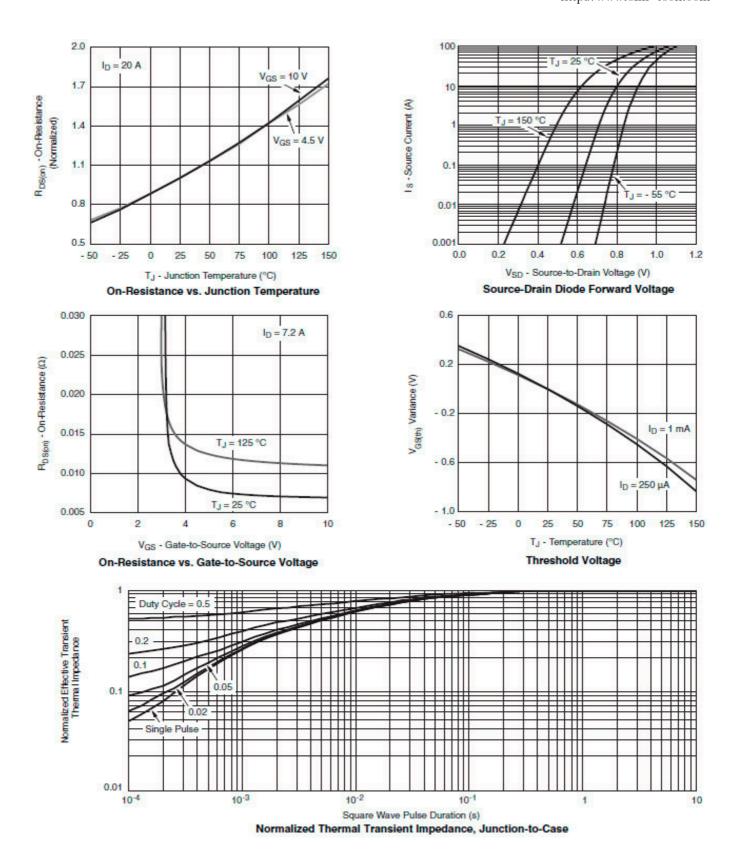
单 N 沟道 MOSFET ELM55004SA-S

/// http://www.elm-tech.com

■标准特性和热特性曲线







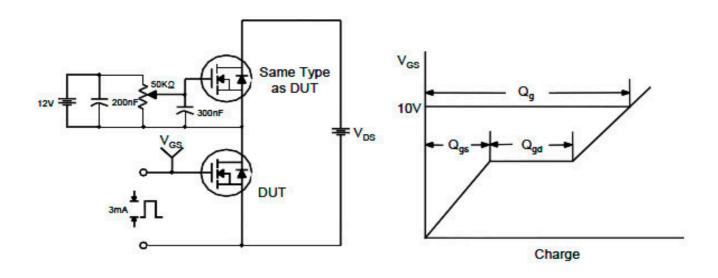


单 N 沟道 MOSFET ELM55004SA-S

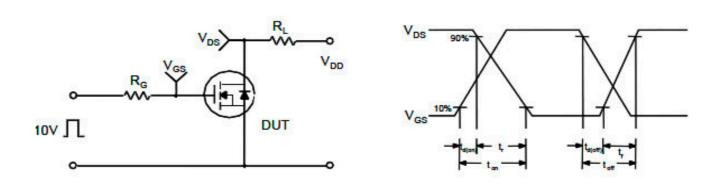
mhttp://www.elm-tech.com

■测试电路和波形

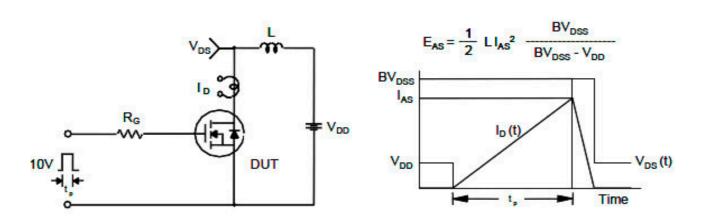
Gate Charge Test Circuit & Waveform



Resistive Switching Test Circuit & Waveforms



Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveforms





™ Rev.1.0